








	<h2 style="color: red;">FQD12N20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD12N20TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD12N20TF.pdf 2.FQD12N20TF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD12N20TF ist neu im Original, Suche FQD12N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD12N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS DPAK 200V 280 MOHM</p>
 <p>FQD12P10 FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD12N20LTM_SN00173 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊗ FQD10N20CTM ⊕ FQD10N20LTF ⊗ FQD10N20TM D FQD11P06TF ⇒ FQD12N20L ⇒ FQD12N20TF ⊗ FQD12P10TF ⊕ FQD13N06LTF ⊗ FQD13N06TF ⇒ FQD13N10L 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD10N20CTM ⊗ FQD10N20LTM ⊕ FQD10N20TM ⊗ FQD11P06TM ⇒ FQD12N20LTF ⇒ FQD12N20TM D FQD12P10TM ⊗ FQD13N06LTF ⊕ FQD13N06TF ⊗ FQD13N10LTF 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD10N20D D FQD10N20LTM ⊗ FQD11P06 ⊕ FQD11P06TM ⊗ FQD12N20LTF D FQD12N20TM ⇒ FQD12P10TM ⇒ FQD13N06LTM ⊗ FQD13N06TM ⊕ FQD13N10LTF 	<ul style="list-style-type: none"> D FQD10N20L ⇒ FQD10N20TF ⇒ FQD11P06-NL ⊗ FQD12N10 ⊕ FQD12N20LTM ⊗ FQD12P10 ⇒ FQD13N06 ⇒ FQD13N06LTM D FQD13N06TM ⊗ FQD13N10LTM 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD10N20LTF ⇒ FQD10N20TF ⇒ FQD11P06TF ⇒ FQD12N20 ⇒ FQD12N20LTM ⊕ FQD12P10TF ⇒ FQD13N06L ⇒ FQD13N06LTM-NL ⇒ FQD13N10 ⇒ FQD13N10LTM
---	---	---	---	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited